**Тигишвили, Марина Георгиевна. Характеристики радиационных дефектов в GaAs, возникающих в результате имплантации селена : автореферат дис. ... кандидата физико-математических наук : 01.04.07 / Рос. АН Физичес. ин-т им. П. Н. Лебедева.- Москва, 1992.- 18 с.: ил. РГБ ОД, 9 92-2/269-x**